### 小野寺研インターン

澤 孝晃

2018年6月27日

### 1 序論

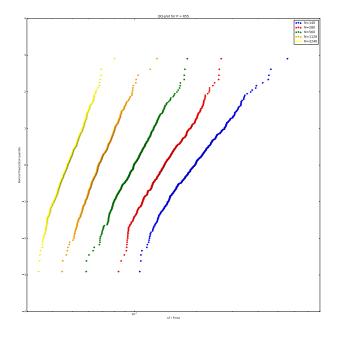
今回のインターンでは、微細デバイスに発生するランダムテレグラフノイズ (RTN) をリング発振回路を用いて測定し、RTN が回路性能の最悪分布に与える影響を評価する。測定対象である RTN は統計的な性質を持っており、各種統計的な性質をモデル化することが目的である。統計的な評価を行うために、同じ寸法の大量のデバイスの電流特性の時間変化を測定し、デバイス毎に観測される電流値変動の振幅および捕獲・放出するまでの平均時間などを測定する。

#### 2 方法

今回の測定環境では、FPGA ボードと PC を使って、スロット 0 からスロット 71 のリングオシレータ (RO) を、セクション 0 からセクション 383 まで 384 個のセクションの発信周波数を測定する。各セクション 10 秒ずつ測定するので、合計 1 時間程度かかる。

#### 3 N skewed の結果

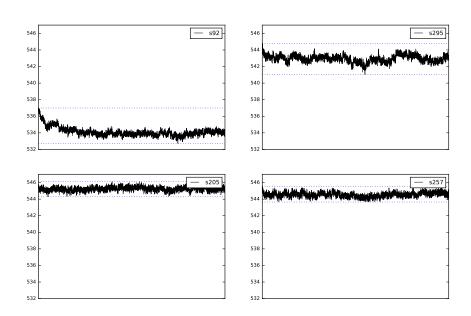
分周した発振周波数の qqplot を描く。qqpolt とは得られたデータと理論分布を比較し、その類似度を調べるためのグラフである。横軸は各分周器にかけられた発振周波数の各セクションでの最大値と最小値の差を最大値で割った値である。縦軸は理論分位数となっている。



	σ	$\mu$
N=140	7.642930	13.013758
N=280	9.290706	17.169270
N=560	10.719097	21.432948
N=1120	13.552113	29.374513
N=2240	14.910113	34.640114

(a) p=655 の時の qqplot

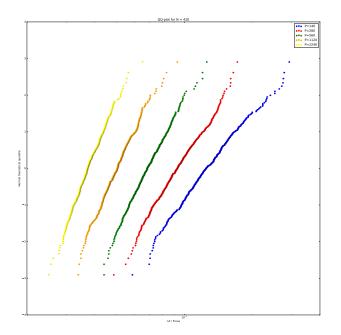
(b) p=655 の時の傾きと切片



(c) p=655, n=2240 の時の波形

 $\boxtimes$  1  $\,$  the effect of the edge length of FET in p = 655  $\,$ 

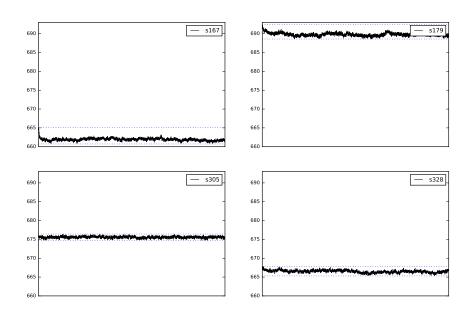
### 4 P skewed の結果



	σ	μ	
P=140	7.995111	15.153213	
P=280	9.720276	19.710795	
P=560	12.113357	26.177423	
P=1120	13.509524	31.045111	
P=2240	15.503079	37.609672	

(a) n=420 の時の qqplot

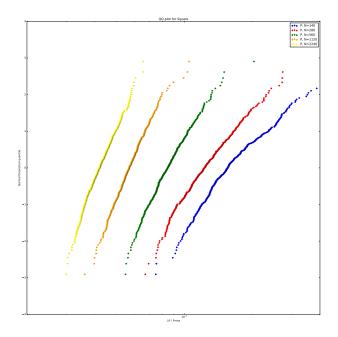
(b) n=420 の時の傾きと切片



(c) n=420, p=2240 の時の波形

 $\boxtimes 2$  the effect of the edg@length of FET in n = 420

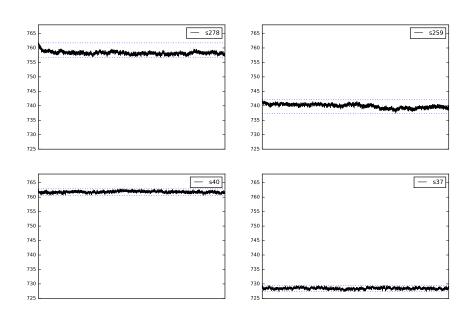
## 5 Balanced の結果



	$\sigma$	μ
P, N=140	6.701765	11.970562
P, N=280	8.040099	15.287765
P, N=560	11.269633	23.320950
P, N=1120	14.117825	31.657139
P, N=2240	15.159114	35.990718

(a) Balanced の時の qqplot

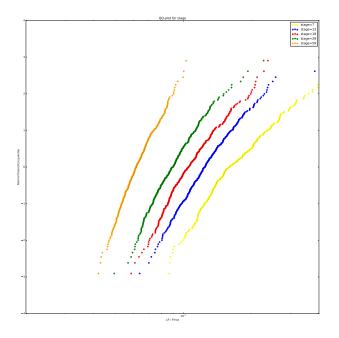
(b) Balanced の時の傾きと切片



(c) n,p=2240 の時の波形

 $\boxtimes 3$  the effect of the size of FET

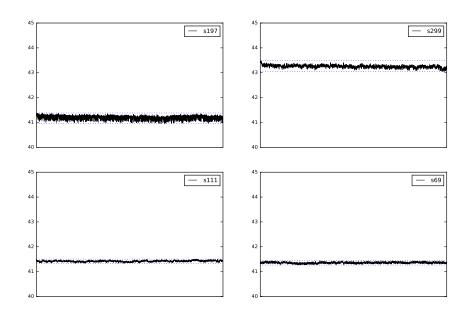
# 6 stage の結果



	σ	μ
stage=7	6.888903	12.195206
stage=13	8.593555	16.301643
stage=19	9.128267	17.957195
stage=29	10.166360	20.770548
stage=59	13.962715	30.766687

(a) stage の時の qqplot

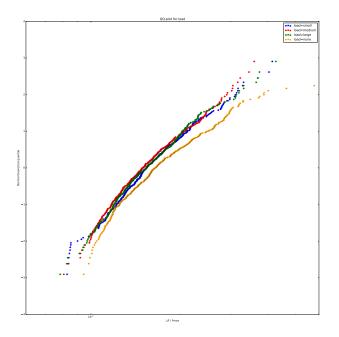
(b) stage の時の傾きと切片



(c) stage=59 の時の波形

 $\boxtimes$  4 the effect of the stage of FET

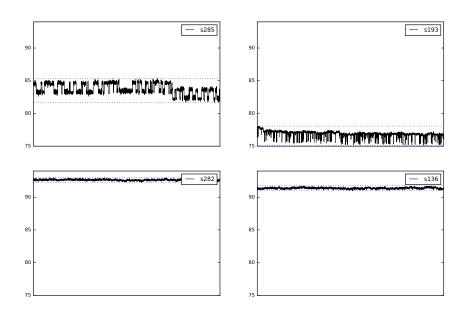
## 7 extra load の結果



	σ	μ
load=small	7.912880	14.213154
load=medium	8.088943	14.633828
load=large	8.043086	14.490517
load=none	6.448896	11.323411

(a) extra load の時の qqplot

(b) extra load の時の傾きと切片



(c) load=large の時の波形

 $\boxtimes 5$  the effect of the extra load of FET